

Сведения о ведущей организации
по диссертации Малина Тимура Валерьевича
на тему: «Эпитаксиальные слои GaN на кремниевых подложках для AlGaIn/GaN
гетероструктур с высокой подвижностью электронов»
по специальности 1.3.11 – «Физика полупроводников», на соискание ученой
степени кандидата технических наук

Полное наименование организации в соответствии с уставом	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники»
Сокращенное наименование организации	Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, ТУСУР
Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования РФ
Почтовый адрес организации	634050, г. Томск, пр. Ленина, 40
Телефон организации	(3822) 51-05-30
Факс организации	(3822) 51-32-62
Адрес электронной почты, сайт организации	e-mail: office@tusur.ru https://tusur.ru

Список основных публикаций работников ведущей организации по теме
оппонируемой диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет

1.	Burdovitsin V.A., Bakeev I.Y., Ngon L.J., Kiki A., Oks E.M., Tyunkov A.V. ELECTRON BEAM EVAPORATION OF SILICON CARBIDE TO PRODUCE SILICON-CARBON COATINGS //High Temperature Material Processes: An International Quarterly of High-Technology Plasma Processes. – 2025. – Т. 29. – №.1. 10.1615/hightempmatproc.v29.i1.10.
2.	Zhidik Y. S. Magnetron sputtering deposition of ITO films on semiconductor heteroepitaxial structures surface //Proceedings of 9th International Congress on Energy Fluxes and Radiation Effects. – EFRE, 2024. 10.56761/EFRE2024.C4-O-054801.
3.	Бартенев А.И., Кагадей В.А., Коряковцев А.С., Полынцев Е.С., Помазанов А.В., Проказина И.Ю., Шеерман Ф.И. Силовая GaN-электроника как фактор роста энергоэффективности преобразователей электрической энергии // Технологии безопасности жизнедеятельности. – 2023. – №.1. – С. 91–100. 10.17223/7783494/1/12.
4.	Udalov A. A., Shesterikov E. V. Study of the semiconductor materials influence in measuring technology on the measure efficiency in upper layers of the atmosphere //29th International Symposium on Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. – SPIE, 2023. – Т. 12780. – С. 1523-1526. 10.1117/12.2690986.
5.	Ишуткин С.В., Арыков В.С., Юнусов И.В., Степаненко М.В., Смирнов В.С., Троян П.Е., Жидик Ю.С. Модулятор Маха-Цендера на основе InP с управляемым коэффициентом экстинкции //Журнал технической физики. – 2023. – Т.93. – №.11. – С. 1622-1630. 10.61011/JTF.2023.11.56494.172-23.
6.	Zhidik Y., Ivanova A., Smirnov S., Zhuk K., Yunusov I., Troyan P. Nanoscale ITO Films for Plasmon Resonance-Based Optical Sensors //Coatings. – 2022. – Т. 12. – №.12. – С. 1868. 10.3390/coatings12121868.

7.	Кудабай Е., Салих А., Мосейчук В.А., Кривцун А., Брагин Д.С., Дмитриев В.Д. // GaN МИС маломощного усилителя X-диапазона. Журнал Радиоэлектроники. – 2021. – №.2. 10.30898/1684-1719.2021.2.12.
8.	Polyntsev E., Erofeev E., Yunusov I. The Influence of Design on Electrical Performance of AlGaIn/GaN Lateral Schottky Barrier Diodes for Energy-Efficient Power Applications //Electronics. – 2021. – Т. 10. – №. 22. – С. 2802. 10.3390/electronics10222802.
9.	Еханин С.Г., Томашевич А.А. Сверхслабое свечение и нестабильности микротоков в синих GaN-светодиодах при разных стадиях деградации //Прикладная физика. – 2021. – №. 6. – С. 74. 10.51368/1996-0948-2021-6-74-82.
10.	Ishutkin S., Arykov V., Yunusov I., Stepanenko M., Smirnov V., Troyan P., Zhidik Y. The Method of Low-Temperature ICP Etching of InP/InGaAsP Heterostructures in Cl ₂ -Based Plasma for Integrated Optics Applications //Micromachines. – 2021. – Т. 12. – №. 12. – С. 1535. 10.3390/mi12121535.
11.	Косов Д.С., Шеерман Ф.И., Бабак Л.И. Разработка прототипа отечественной САПР для проектирования СВЧ-устройств и GaAs/GaN МИС //Наноиндустрия. – 2020. – Т. 13. – №. S4. – С. 374-376. 10.22184/1993-8578.2020.13.4s.374.376.
12.	Торхов Н. А., Новиков В. А. Исследование электростатической системы поверхности кристаллов AuNi/GaN диодов Шоттки методом зонда Кельвина атомно-силовой микроскопии //Физика и техника полупроводников. – 2020. – Т. 54. – №. 3. – С. 266-274. 10.21883/FTP.2020.03.49031.9203.
13.	Кондратенко А.В., Брагин Д.С., Зыков Д.Д. Монолитные интегральные схемы функциональных узлов радиотракта ППМ АФАР X-диапазона на основе арсенид-галлиевых и нитрид-галлиевых технологических процессов //Проблемы разработки перспективных микро-и наноэлектронных систем (МЭС). – 2020. – №. 4. – С. 193-199. 10.31114/2078-7707-2020-4-193-199.
14.	Ishutkin S., Arykov V., Yunusov I., Stepanenko M., Troyan P., Zhidik Y. Technological development of an InP-based Mach–Zehnder modulator //Symmetry. – 2020. – Т. 12. – №. 12. – С. 2015. 10.3390/sym12122015.

Профессор кафедры Физическая электроника, председатель диссертационного совета 1.3.5 (Физическая электроника), 1.3.8 (Физика конденсированного состояния) ТУСУР,

доктор технических наук

Троян П.Е.

И.о. проректор по науке

Довник А.В.
_____ 2025 г.